

**97-0252**

Изобретение относится к области радиоэлектронной техники и может быть использовано при изготовлении фотоприемников и оптоэлектронных устройств на их основе.

Сущность изобретения заключается в том, что в способе получения тонкопленочных гетероструктур на основе соединения  $A^2B^5$ , включающем осаждение слоев в вакууме при наличии градиента температур между испарителем и подложкой, сначала осаждают слой с узкозонной компонентой, обрабатывают его в растворе соли, отжигают и травят, а затем осаждают слой с широкозонной компонентой.

Технический результат изобретения заключается в увеличении количества носителей заряда.